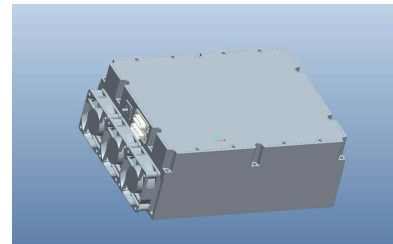


8000–12000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W

GaN 증폭기는 8000–12000 MHz에서 전형 포화 출력 100 W와 최소 이득 53 dB를 제공합니다. 1 dB 압축점 전형 출력은 20 W, 이득 평탄도는 ± 1.5 dB입니다.



전기 사양 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	8000	-	12000	MHz
1 dB 압축점 출력 전력	P-1dB	-	20	-	W
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	53	-	-	dB
전력 이득 평탄도 @ PSAT	ΔGp	-	± 1.5	-	dB
입력 반사 손실	S11	-	-15	-	dB
스퓨리어스 신호 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
입출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	-	VDC

절대 최대 정격

항목	정격
손상이 발생하지 않는 RF 입력 전력	+10 dBm 최대
Pout = 100 W 조건의 부하 VSWR	∞ ; 모든 부하 위상 및 진폭, 연속
열 과부하	85 °C → 정지 (최대)

환경 사양 · 설계 목표; 프로젝트별 확인 필요

항목	최솟값	일반값	최댓값	단위	비고
동작 온도	-20	-	50	°C	-
보관 온도	-25	-	65	°C	보관 온도
상대 습도(비응축)	-	-	95	%	-

기구 사양

항목	값	단위
외형 치수	250 × 200 × 100 mm (최대)	mm
중량	5.7 kg (최대)	kg
RF 입력 커넥터	SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	N-K	-
DC/제어 인터페이스	하이브리드, D-Sub 7W2, 수	-

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
A1	A1 — 접지	접지
A2	A2 — 전원 양극	+28V
1	1 — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운
2	2 — 접지	접지
3	3 — 온도 감지 출력	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — 전류 감지 출력	100 mV/A
5	5 — 접지	접지

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.